**ران اد**ار ش

## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSÄMMENABBEIT AUF DEM EBIET DES PATENTWESENS 1 3 0CT 2004

### PCT

WIPO PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBI

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 449 002 P-WO				WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/12433				Internationales Anmelde 06.11.2003	edatum (Tag/M	Ionat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatJahr) 27.11.2002	
1	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01L33/00							
1	Anmelder VERTILAS GMBH							
1.	<ol> <li>Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</li> </ol>							
2.	Dies	er BE	RICHT umfaßt insgesar	nt 6 Blätter einschließl	ich dieses De	eckblatts.		
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).							
	Dies	e Anl	agen umfassen insgesa	mt Blätter.				
3.	3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:							
	I ⊠ Grundlage des Bescheids							
	11		Priorität					
]	Ш		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neut	eit, erfinderis	sche Tätigl	keit und gewerbliche Anwendbarkeit	
İ	IV		Mangelnde Einheitlich	keit der Erfindung				
	٧	×					it, der erfinderischen Tätigkeit und der ıng dieser Feststellung	
	VI		Bestimmte angeführte	Jnterlagen				
	VII		_	internationalen Anmel				
	VIII   Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung							
Datum der Einreichung des Antrags  Datum der Fertigstellung dieses Berichts								
24.0	24.06.2004			12.10.200	4			
	Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde				Bevollmächt	igter Bedien	steter	
Europäisches Patentamt D-80298 München					Riechel, S	<b>;</b>		Age sa Pa
	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			Tel. +49 89 2		Ta John Company of the Company of th	1	

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/12433

I.	Grun	dlage	des	<b>Berichts</b>
••	w	- ugc	uco.	Delicitio

Beschreibung, Seiten

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

		•				
	1-	16	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	An	nsprüche, Nr.				
	1-2	22	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ze	ichnungen, Blätter				
	1/5	-5/5	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
2.		Hinsichtlich der <b>Sprache</b> : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	Die ein	Bestandteile stande gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache elt es sich um:			
		die Sprache der Üb (nach Regel 23.1(b	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist )).			
		die Veröffentlichung	gssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).			
		die Sprache der Üb	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht egel 55.2 und/oder 55.3).			
3.	Hin inte	sichtlich der in der in ernationale vorläufige	ternationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internationale	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
			nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
		bei der Behörde nac	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.			
			chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
		Die Erklärung daß d	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß d	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen ntsprechen, wurde vorgelegt.			
4.	l. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/12433

5. 🗆	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).
------	--

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-22

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche 1-22

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

la: Ansprüche: 1-22

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 1.
  - D1: DE 101 07 349 A (AMANN MARKUS-CHRISTIAN ; ORTSIEFER MARKUS (DE)) 29. August 2002 (2002-08-29)
  - D2: LIAU Z L ET AL: "A novel technique for GalnAsP/InP buried heterostructure laser fabrication" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 40, Nr. 7, 1. April 1982 (1982-04-01), Seiten 568-570, XP000706414 ISSN: 0003-6951
  - D3: US-A-5 661 075 (LEBBY MICHAEL S ET AL) 26. August 1997 (1997-08-26)
- Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die 2. Ansprüche 11 und 16 nicht klar sind.
- In den Erzeugnisansprüchen 11 und 16 wird versucht den Gegenstand mittels des 2.1 Verfahrensschritts M1 zur Herstellung des Erzeugnisses definiert, nämlich dadurch, dass der Tunnelkontakt bzw. die weitere Halbleiterschicht lateral von einem Bereich umgeben ist, der
  - M1: "durch Massetransport aus zumindest einer dieser angrenzenden Schichten entstanden ist".
  - Dieser Ausdruck ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche nicht klar ist (Artikel 6 PCT).
- 2.2 Anspruch 11 wird im folgenden so interpretiert, dass er sich auf ein Erzeugnis bezieht, das durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellt ist, d.h. als ob M1 ersetzt wäre durch den Ausdruck:

"durch Massetransport aus zumindest einer dieser angrenzenden Schichten entstanden ist, indem die für den Tunnelkontakt vorgesehene Schicht in einem ersten Schritt mittels materialselektiver Ätzung bis zum gewünschten Durchmesser des Tunnelkontakts lateral abgetragen wird und in einem zweiten Schritt in einer geeigneten Atmosphäre so lange erhitzt wird, bis der geätzte Spalt durch Massentransport aus zumindest einer an den

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Tunnelkontakt grenzenden Halbleiterschicht geschlossen ist."

- 2.3 Die Interpretation des Merkmals M1 in Anspruch 16 erfolgt in analoger Weise.
- Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem 3. Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Verfahren zur Herstellung eines vergrabenen Tunnelkontakts 40, 41 in einem oberflächenemittierenden Halbleiterlaser (Fig. 1) mit einer einen pn-Übergang aufweisenden aktiven Zone 22 umgeben von einer ersten n-dotierten Halbleiterschicht 21 und mindestens einer p-dotierten Halbleiterschicht 23, und mit einem Tunnelkontakt 40, 41 auf der p-Seite der aktiven Zone 22, der an eine zweite n-dotierte Halbleiterschicht 24 grenzt

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem bekannten 3.1 Verfahren dadurch, dass

die für den Tunnelkontakt vorgesehene Schicht in einem ersten Schritt mittels materialselektiver Ätzung bis zum gewünschten Durchmesser des Tunnelkontakts lateral abgetragen wird und in einem zweiten Schritt in einer geeigneten Atmosphäre so lange erhitzt wird, bis der geätzte Spalt durch Massentransport aus zumindest einer an den Tunnelkontakt grenzenden Halbleiterschicht geschlossen ist.

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 3.2
- Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann darin gesehen 3.3 werden, das Herstellungsverfahren des vergrabenen Tunnelkontakts so zu vereinfachen, dass kein zweiter Epitaxieschritt notwendig ist.
- Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene 3.4 Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT): Die Methode des Massentransports mag einem Fachmann zwar im Zusammenhang mit der Herstellung vergrabener Heterostrukturen bekannt sein, siehe z.B. D2 und D3, der Fachmann würde dadurch jedoch nicht veranlasst das in D1 offenbarte Verfahren im Sinne des Anspruchs 1 abzuändern, da weder D2 noch D3 die Herstellung vergrabener Tunnelkontakte andeutet.

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

- Gemäß der oben erläuterten Interpretation des Anspruchs 11 beinhaltet der 4 Gegenstand des Anspruchs 11 einen Halbleiterlaser der durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 hergestellt ist. Das Herstellungsverfahren mittels Massentransport bedingt Eigenschaften hinsichtlich Struktur und Form die sich von denen eines mittels Zweifachepitaxie hergestellten Halbleiterlasers gemäß D1 unterscheiden (siehe PCT Richtlinien, Abschnitt 5.27) . Der Gegenstand des Anspruchs 11 ist daher neu (Artikel 33(2) PCT) und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).
- Die Ansprüche 2-10 sowie 12-22 sind von den Ansprüchen 1 bzw. 11 abhängig 5. und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

HAS OF COURT PCT/EP2003/012433

# PATENT COOPERATION TREATY



#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 449 002 P-WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No. PCT/EP2003/012433	International filing date (day/month/year)  Of November 2003 (06.11.2003)  Priority date (day/month/year)  27 November 2003 (27.11.2003)				
PCT/EP2003/012433 06 November 2003 (06.11.2003) 27 November 2002 (27.11.2002)  International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L33/00 .					
Applicant	VERTILAS GMBH				
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.  2. This REPORT consists of a total of					
Date of submission of the demand  Date of completion of this report					
24 June 2004 (24.06.2)	Date of completion of this report  12 October 2004 (12.10.2004)				
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer				
Facsimile No.	Telephone No.				

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

Translation





⊢	I. Basis of the report						
1.	With		to the elements of the international application:*				
		the international application as originally filed					
	$\boxtimes$	the des	scription:				
		pages	i-16	, as originally filed			
		pages		<del></del>			
		pages	, filed with the letter of				
	$\square$	the clai	<del></del>				
	لحا	pages		as originally filed			
		pages		, as originally filed			
		pages					
		pages	, filed with the letter of				
	$\square$						
	$\square$	the drav	-				
ĺ		pages	1/5-5/5	, as originally filed			
İ		pages pages		, filed with the demand			
			, filed with the letter of				
	L t	he seque	ence listing part of the description:				
		pages		, as originally filed			
		pages		, filed with the demand			
		pages	, filed with the letter of				
2.	me m	the lang	nguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule nguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).  Inguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary e	which is: 23.1(b)).			
3.	With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:  contained in the international application in written form.  filed together with the international application in computer readable form.  furnished subsequently to this Authority in written form.  furnished subsequently to this Authority in computer readable form.						
		The sta	tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not g	go beyond the disclosure in the			
		The sta	ational application as filed has been furnished.  tatement that the information recorded in computer readable form is identical to urnished.				
4.		The am	nendments have resulted in the cancellation of:				
!			the description, pages				
ı			the claims, Nos.				
			the drawings, sheets/fig				
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	e they have been considered to go			
	* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).						
**	** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.						

1	application No.
PCT	03/12433

NO

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
1.	Statement						
	Novelty (N)	Claims	1-22	YES			
		Claims		NO			
	Inventive step (IS)	Claims	1-22	YES			
	·	Claims		NO			
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-22	YES			

- 2. Citations and explanations
  - 1. Reference is made to the following documents:

Claims

- D1: DE 101 07 349 A (AMANN MARKUS-CHRISTIAN;
  ORTSIEFER MARKUS (DE)) 29 August 2002
  (2002-08-29)
- D2: LIAU Z L ET AL: "A novel technique for GalnAsP/InP buried heterostructure laser fabrication" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Vol. 40, No. 7, 1 April 1982 (1982-04-01), pages 568-570, XP000706414 ISSN: 0003-6951
- D3: US-A-5 661 075 (LEBBY MICHAEL S ET AL) 26 August 1997 (1997-08-26)
- 2. The application does not meet the requirements of PCT Article 6 because claims 11 and 16 are unclear.
- 2.1 In product claims 11 and 16 an attempt is made to define the subject matter by means of the method step M1 for producing the product, namely in that the tunnel contact or the further semiconductor layer is laterally surrounded by a region which M1: "has resulted from mass transport from at least one of these adjacent layers".

This phrase is vague and unclear and leaves the reader uncertain as to the meaning of the technical features in question. As a result, the subject matter of said claims is not clearly defined (PCT Article 6).

2.2 Claim 11 is hereinafter interpreted as if it related to a product that is produced using a method as per claim 1, that is as if M1 were replaced by the following:

"has resulted from mass transport from at least one of these adjacent layers, in that the layer provided for the tunnel contact is removed laterally in a first step by means of material-selective etching until the tunnel contact has the desired diameter and is heated in a second step in a suitable atmosphere until the etched gap is sealed by mass transport from at least one of the semiconductor layers bordering the tunnel contact".

- 2.3 Feature M1 in claim 16 is interpreted in the same way.
- 3. Document D1 is considered the prior art closest to the subject matter of claim 1 and discloses (the references between parentheses refer to that document):

method for producing a buried tunnel contact 40, 41 in a surface-emitting semiconductor laser (figure 1) which comprises an active zone 22 with a pn junction, said zone being surrounded by a first n-doped semiconductor layer 21 and at least one p-doped semiconductor layer 23, and comprising a tunnel contact 40, 41 on the p-side

of the active zone 22, said tunnel contact bordering a second n-doped semiconductor layer 24.

3.1 The subject matter of claim 1 differs from the known method in that

the layer provided for the tunnel contact is removed laterally in a first step by means of material-selective etching until the tunnel contact has the desired diameter and is heated in a second step in a suitable atmosphere until the etched gap is sealed by mass transport from at least one of the semiconductor layers bordering the tunnel contact.

- 3.2 The subject matter of claim 1 is thus novel (PCT Article 33(2)).
- 3.3 The present invention can be considered to address the problem of simplifying the method for producing the buried tunnel contact so that no second epitaxy step is needed.
- The solution to this problem proposed in claim 1 of the present application involves an inventive step (PCT Article 33(3)) for the following reasons: although a person skilled in the art may be familiar with mass transport methods in relation to the production of buried heterostructures (see, for example D2 and D3), he would not thereby be prompted to modify the method disclosed in D1 in line with what is proposed in claim 1, since neither D2 nor D3 refers to the production of buried tunnel contacts.

- 4. According to the above interpretation of claim 11, the subject matter of the claim concerns a semiconductor laser that is produced using a method as per claim 1. The production method involving mass transport produces properties relating to structure and form which differ from those of a semiconductor laser produced using dual epitaxy, as per D1 (see the PCT Guidelines, section 5.27). The subject matter of claim 11 is thus novel (PCT Article 33(2)) and involves an inventive step (PCT Article 33(3)).
- 5. Claims 2 to 10 and 12 to 22 are dependent on claims 1 and 11, respectively, and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.